



Comunicado de prensa

KIOXIA presenta los dispositivos de memoria flash integrada versión 4.1.

Los nuevos dispositivos UFS con la 8.ª generación BiCS FLASH™⁽¹⁾ de KIOXIA aumentan la velocidad y la eficiencia energética



Düsseldorf, Alemania, 9 de julio de 2025: [KIOXIA Europe GmbH](#) ha anunciado hoy que ha empezado a distribuir muestras de los nuevos dispositivos de memoria flash universal integrada⁽²⁾ (UFS) 4.1, lo que refuerza su liderazgo en materia de almacenamiento de alto rendimiento. Diseñados para satisfacer las demandas de las aplicaciones móviles de próxima generación, entre ellos, los smartphones avanzados con IA integrada, los nuevos dispositivos ofrecen un rendimiento mejorado con una mayor eficiencia energética⁽³⁾, en un pequeño paquete BGA.

Los dispositivos 4.1 de KIOXIA cuentan con la innovadora memoria flash 3D BiCS FLASH™ de la empresa y un controlador en un paquete estándar JEDEC®. Estos nuevos dispositivos UFS están diseñados con la 8.ª generación de memoria flash 3D BiCS FLASH™ de KIOXIA⁽¹⁾. Esta generación introduce la tecnología CBA (CMOS directly Bonded to Array), una innovación arquitectónica que supone un cambio radical en el diseño de la memoria flash.

Al unir directamente los circuitos CMOS a la matriz de memoria, la tecnología CBA ofrece importantes mejoras en eficiencia energética, rendimiento y densidad.

Con una combinación de velocidad y bajo consumo, los dispositivos UFS 4.1 de KIOXIA están diseñados para mejorar la experiencia del usuario, de tal forma que las descargas sean más rápidas y el rendimiento de las aplicaciones más fluido.

Estas son sus características principales:

- Capacidades de 256, 512 gigabytes (GB) y 1 terabyte (TB)
- Mejora del rendimiento en comparación con la generación anterior⁽³⁾:
 - Escrituras aleatorias: 512 GB/1 TB aprox. +30 %
 - Lecturas aleatorias: 512 GB +45 % aprox., 1 TB +35 % aprox.
 -
- Mejora de la eficiencia energética respecto a la generación anterior⁽³⁾:
 - Lecturas: 512 GB/1 TB aprox. +15 % de mejora
 - Lecturas: 512 GB/1 TB aprox. +20 % de mejora
- La desfragmentación iniciada por el host permite retrasar la recogida de basura para obtener un rendimiento sin interrupción en momentos críticos.
- El redimensionamiento del búfer WriteBooster proporciona mayor flexibilidad para un rendimiento óptimo
- Compatible con el estándar UFS 4.1
- Altura del paquete reducida para el modelo de 1 TB en comparación con la generación anterior⁽⁴⁾
- Funciona con la memoria 3D flash BiCS FLASH™ de 8.ª generación de KIOXIA⁽¹⁾

«Los nuevos dispositivos de memoria integrada UFS 4.1 de KIOXIA suponen un avance notable, que refuerza el liderazgo de KIOXIA en materia de almacenamiento de alto rendimiento y su compromiso de liderar la innovación en almacenamiento flash», afirma Axel Störmann, vicepresidente y director de Tecnología de Productos de Memoria y SSD de KIOXIA Europe GmbH. «Diseñados con BiCS FLASH™ de 8.ª generación y tecnología CBA, estos dispositivos satisfacen las demandas de las aplicaciones móviles de nueva generación del mañana, como la IA integrada en dispositivos, lo que supone un salto significativo respecto a sus predecesores».

###

Notas:

(1) Solo modelos de 512 GB/1 TB.

(2) El almacenamiento flash universal (UFS) es la categoría de una clase de productos de memoria integrada desarrollados de acuerdo con la especificación estándar de UFS de JEDEC. Debido a su interfaz en serie, UFS es compatible con dúplex completo, lo que permite tanto la lectura como la escritura simultáneas entre el procesador host y el dispositivo UFS.

(3) En comparación con la generación anterior de dispositivos de 512 GB «THGJFMT2E46BATV» y 1 TB «THGJFMT3E86BATZ» respectivamente (solo modelos de 512 GB/1 TB).

(4) El dispositivo de 1 TB de la generación anterior «THGJFMT3E86BATZ».

*En cada mención de un producto KIOXIA: La densidad del producto se identifica en función de la densidad de los chips de memoria dentro del producto, no en función de la cantidad de capacidad de memoria disponible para el almacenamiento de datos por parte del usuario final. La capacidad utilizable por el consumidor será menor debido a las áreas de datos generales, al formato, a los bloques defectuosos y a otras restricciones, y también podrá variar según el dispositivo host y la aplicación. Para más información, consulte las especificaciones del producto correspondiente. Definición de 1 KB = 2^{10} bytes = 1024 bytes. Definición de 1 Gb = 2^{30} bits = 1 073 741 824 bits. Definición de 1 GB = 2^{30} bytes = 1 073 741 824 bytes. 1 Tb = 2^{40} bits = 1 099 511 627 776 bits. 1 TB = 2^{40} bytes = 1 099 511 627 776 bytes.

*Las velocidades de lectura y escritura son los mejores valores obtenidos en un entorno de prueba específico de KIOXIA Corporation. KIOXIA Corporation no garantiza esta velocidad de lectura ni de escritura en todos los dispositivos. La velocidad de lectura y escritura puede variar en función del dispositivo utilizado y del tamaño del archivo leído o escrito.

*Los nombres de empresas, nombres de productos y nombres de servicios mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus empresas terceras.

*Las siguientes marcas comerciales, servicios o nombres de empresas, JEDEC, JEDEC Solid State Technology Association, no han sido aplicados, registrados o creados por KIOXIA Europe GmbH, ni son propiedad de la empresa o de empresas afiliadas al grupo KIOXIA. No obstante, es posible que estas sí hayan sido solicitadas o registradas por terceros en diversas jurisdicciones, hayan sido creadas por estos o sean de su propiedad y, por este motivo, estén protegidas de usos no autorizados. El resto de los nombres de empresas, nombres de productos y nombres de servicios mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus empresas terceras.

Acerca de KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (antes Toshiba Memory Europe GmbH) es la filial europea de KIOXIA Corporation, un proveedor líder mundial de memorias flash y unidades de memoria de estado sólido (SSD). Desde la invención de la memoria flash NAND hasta la revolucionaria introducción de BiCS FLASH™, KIOXIA continúa siendo pionera en la oferta de soluciones y servicios de memoria de vanguardia que enriquecen la vida de las personas y amplían los horizontes de la sociedad. La

innovadora tecnología de memoria flash 3D de KIOXIA, BiCS FLASH™ está transformando el futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, como los teléfonos inteligentes avanzados, ordenadores, unidades SSD, sector automotriz y centros de datos.

Visite el [sitio web de KIOXIA](#)

Datos de contacto para la publicación:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemania

Tel.: +49 (0)211 368 77-0

Correo electrónico: KIE-support@kioxia.com

Datos de contacto para consultas editoriales:

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel.: +49 (0) 211 36877 382

Correo electrónico: [lena1.hoffmann@kioxia.com](mailto:lana1.hoffmann@kioxia.com)

Publicado por:

Birgit Schöninger, Publitek

Tel: +49 (0)4181 968098-13

Correo electrónico: birgit.schoeniger@publitek.com

Sitio web: www.publitek.com